

高温超导体中约瑟夫森涡旋流阻的振荡效应^{*}

尤育新[†] 赵志刚 王 进 刘 楣

(东南大学物理系, 南京 210096)

(2008 年 1 月 7 日收到 2008 年 4 月 20 日收到修改稿)

通过数值计算耦合 sine-Gordon 方程组研究高温超导体中约瑟夫森涡旋的运动, 得到约瑟夫森涡旋电压和流阻随平面磁场和驱动电流的变化规律. 固定驱动电流, 约瑟夫森涡旋电压和流阻随着磁场的增大出现周期性的振荡行为, 振荡周期与每层约瑟夫森结中进入一个磁通量子相对应. 分析和阐明了产生这种周期性振荡的原因.

关键词: 约瑟夫森涡旋, 涡旋格子, 高温超导

PACC: 7460E, 7470J, 7450

1. 引 言

铜氧化物超导体具有弱耦合层状结构的重要特征, 在磁场中其输运性质表现出很强的各向异性. 在外加磁场平行于超导体的铜氧面层时, 磁通线将穿透非超导层, 形成约瑟夫森涡旋 (JV) 格子. 而垂直于平面的磁场形成的磁通被称为饼涡旋 (PV) 格子^[1]. 每个约瑟夫森涡旋中心带有一个磁通量子, 在垂直于平面方向加上一个驱动电流 γ , JV 运动是由平面内的超流和平面间本征约瑟夫森隧道电流构成的^[2-4].

高温超导体中的约瑟夫森涡旋运动表现出特殊的输运性质, 引起了近年来实验和理论工作者极大的研究兴趣^[5-7]. 2002 年 Ooi 等人测量 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+y}$ 单晶中的 JV 流阻^[8], 首先发现在一个较大的磁场范围内, JV 流阻随磁场的变化出现周期性的振荡行为, 振荡周期为 $\frac{\phi_0}{2sL}$, L 表示样品的平面宽度, s 表示 z 方向晶格长度. 这种振荡周期与每两层结的区域增加一个磁通量子相对应. 数值计算表明这种振荡是 JV 格子和 L 的匹配效应引起的^[9]. 进一步的实验研究发现, 在样品的平面宽度 L 与约瑟夫森穿透深度 λ_J 同数量级的实验样品中, JV 流阻会随着磁场的增大出现周期为 $H_p = \frac{\phi_0}{sL}$ 的振荡^[10, 11].

周期 H_p 与每一层结中增加一个磁通量子相对应. JV 流阻的研究对基础理论和应用有重要作用^[12].

本文通过数值计算 sine-Gordon 方程组, 研究高温超导体中的约瑟夫森涡旋运动, 得到 z 方向 JV 电压 V 随驱动电流 γ 和平行于平面磁场 h 的变化规律. 发现在驱动电流增大到退钉扎临界电流 γ_d 时, 部分 JV 退钉扎形成紊乱的塑性运动. 在驱动电流增大到一个动力学临界电流 γ_m 时, JV 完全被融化并表现出一个稳定 JV 格子整体流动行为. 融化后形成的稳定 JV 流阻值表明在 z 方向存在很强的本征钉扎. 固定一个小的测量电流, 增加磁场到一个临界磁场 h_m 后, JV 电压随着磁场的变化出现周期性振荡行为. 这与实验上发现的高温超导体中 JV 流阻随磁场的变化出现周期性振荡行为相符合^[10]. 我们分析了产生这种周期性振荡的原因. 发现在样品中涡旋量子形成三角形 JV 格子, 其线性运动产生了稳定的电压和流阻. 当每两个约瑟夫森结中增加 1 个涡旋中心, 三角形的 JV 格子周期性被破坏, 相对应无序 JV 格子流动产生较小的电压和较低的流阻. 由此 JV 流阻随磁场的增加产生了振荡行为, 其振荡周期与每个约瑟夫森结中增加一个涡旋中心相对应 $\Delta h_p = 1$. JV 格子流阻随磁场变化的振荡行为是由于边界对量子化磁通的调制, 不同构型的 JV 格子流动形成不同流阻.

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 10574021, 10647114) 高等学校博士学科点专项科研基金 (批准号: 20060286044) 资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail: ykx82@e172.com

2. 模型和方程

图 1 为高温超导体中约瑟夫森涡旋格子结构示意图. 高温超导体为层状结构, 图中薄层为超导层 (Cu-O 层) 其厚度为 t . 两个超导层之间为载流子源层, 其厚度为 d . z 方向一个本征约瑟夫森结厚度为晶格常数 $s = t + d$. 样品在 x 方向的宽度为 L . 当外加磁场 H 沿 y 方向, 驱动电流密度 j 沿负 z 方向, 磁通受到 x 方向的洛伦兹力 F 的作用而产生运动, 引起约瑟夫森涡旋的变化. 我们研究驱动电流引起 JV 变化在 z 方向的传播引起的电压 V 和流阻 R_{JV} .

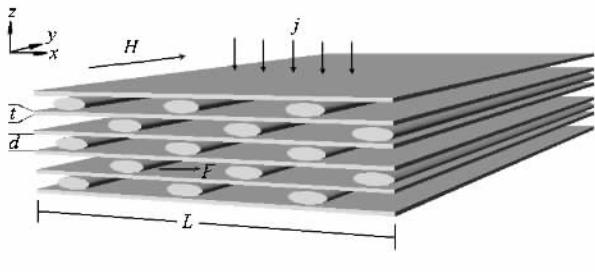


图 1 高温超导体中约瑟夫森涡旋格子结构示意图

首先在 x - z 平面上选取一个 x 方向的宽为 L , z 方向含有 N 个约瑟夫森结的系统, 该系统有 N 层非超导层和 $N + 1$ 层超导层. 定义 $\phi_i(x, \tau)$ 为与第 i 个约瑟夫森结相邻两超导层之间的规范不变相位差. $\phi_i(x, \tau)$ 是时间 τ 位置 x 的函数, 相位差 $\phi_i(x, \tau)$ 的变化满足 sine-Gordon 动力学方程组^[13]

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \partial_x^2 \phi_i \\ \phi_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & S & & 0 \\ S & 1 & S & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & S & 1 & S \\ 0 & & & S & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1 \\ J_i \\ J_N \end{pmatrix}, \quad (1)$$

式中 N 维方阵表达了相邻约瑟夫森结之间的耦合. J_i 为穿过第 i 个约瑟夫森结的 z 方向规格化电流密度. S 表示相邻结的耦合强度, 其表达式为

$$S = - \frac{\lambda_L}{d \sin(k t / \lambda_L) + 2 \lambda_L \cos(k t / \lambda_L)}, \quad (2)$$

式中 λ_L 为伦敦穿透深度. 采用电阻电容分路

(RCSJ) 模型, 规格化电流密度 J_i 表达式为

$$J_i = \frac{\partial^2 \phi_i}{\partial \tau^2} + \alpha \frac{\partial \phi_i}{\partial \tau} + \sin \phi_i - \gamma, \quad (3)$$

式中右侧第一项 ϕ_i 关于时间 τ 的二阶导数为位移电流项. 第二项为正常电流项, $\alpha = \sqrt{\hbar \kappa (2 e j_c R^2 C)}$ 为阻尼系数, 其中 j_c, R, C 分别表示约瑟夫森结的临界电流密度、单位面积的正常结电阻和结电容. 第三项为约瑟夫森隧道电流项. 第四项 γ 为 z 方向驱动电流密度, $\gamma = j / j_c$. 以上公式中电流值由临界电流密度 j_c 规格化, 位置 x 和时间 τ 分别由约瑟夫森穿透深度 $\lambda_J = \sqrt{\hbar \kappa (2 e \mu_0 j_c (d + 2 \lambda_L))}$ 及约瑟夫森等离子频率 $\omega_p = \sqrt{2 e j_c \kappa (h C)}$ 规格化.

假设外加磁场为均匀磁场, 方程 (1) 中不包含磁场项, 磁场只出现在边界条件中. 方程 (1) 在 x 方向的边界条件为

$$\left. \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \right|_{x=0, L} = \frac{H}{j_c \lambda_J} \equiv h \frac{2\pi}{L}, \quad (4)$$

式中 h 表示每个本征约瑟夫森结中含有的 JV 中心的个数. 我们所取的参数为 $S = -0.4997$, $\alpha = 0.1$, $N = 5$, $L = 5$. 用有限差分方法求解非线性偏微分方程组 (1), 得到某一时刻、某一位置约瑟夫森电压是相位差 $\phi_i(x, \tau)$ 的时间变化率 $\frac{\partial \phi_i(x, \tau)}{\partial \tau}$. 对时间 τ 和位置 x 求 $\frac{\partial \phi_i(x, \tau)}{\partial \tau}$ 的系综平均值, 得到第 i 个约瑟夫森结电压为

$$\omega^i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{K(T - \tau_0)} \int_{\tau_0}^T \int_0^L \frac{\partial \phi_i}{\partial \tau} dx d\tau. \quad (5)$$

我们定义由驱动电流 γ 引起的涡旋相位在 z 方向传播的平均速度为平均结电压 $V \equiv \frac{1}{N} \sum_1^N \omega^i$. z 方向上下两个界面的 JV 电压越大, JV 流阻越大 $R_{JV} = V / \gamma$. 因此流阻越大 JV 电压越高表示位相运动在本征约瑟夫森结中的隧穿阻力越大, 磁通在 z 方向运动被钉扎在结上而产生的电压越大.

3. 结果和讨论

首先, 我们计算了磁场 h 分别等于 0, 0.5 和 1 三种情况下 JV 电压 V 随电流 γ 的变化关系, 表示在图 2 中. 图中 $h = 0$ 的数据用方块符号表示, $h = 0.5$ 用圆圈符号表示, $h = 1$ 用三角符号表示, 符号之间用直线连接以示清晰.

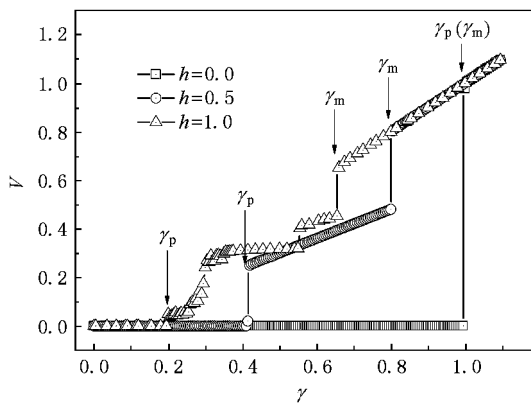


图2 不同磁场下 JV 电压 V 随驱动电流 γ 的变化曲线

我们从图 2 中的 $V-\gamma$ 曲线形状来分析 JV 格子运动. 首先定义 γ_d 为退钉扎临界电流密度. 当驱动电流 $\gamma < \gamma_d$ 时, 涡旋被钉扎. 当驱动电流 $\gamma > \gamma_d$ 时, 涡旋开始运动产生了有限电阻. 由于在一个强关联涡旋系统中存在很强的钉扎效应, 当驱动电流较弱时, 只有很少部分涡旋被融化开始运动, 表现出较小的黏滞阻力. 随着被融化涡旋数量的增加阻力也增大. 当驱动电流增大到一个临界电流 γ_m 时, 涡旋全部被融化. 因此我们定义 γ_m 为 JV 格子的动力学融化临界电流密度. 当 $\gamma > \gamma_m$, 全部融化的涡旋在相互作用下形成关联格子的集体运动. JV 格子的集体运动与驱动电流成线性关系, 流阻为一稳定的常数值. 从图 2 中的 $V-\gamma$ 曲线可以看出: 1) 在没有外磁场情况下 $\gamma_d = \gamma_m = 1$, 这说明涡旋对的退钉扎临界电流与融化临界电流相同且最大, 它就等于超导的临界电流密度. 2) 在磁场增加到 $h = 0.5$ 和 1 , 退钉扎临界电流密度 γ_d 分别减小到 0.4 和 0.2 , 融化电流密度 γ_m 分别减小到 0.8 和 0.65 . 这是由于当进入超导体的磁场密度增加, 涡旋之间相互作用使在较小的驱动电流作用下更容易被驱动和融化. 3) 当驱动电流在 $\gamma_d < \gamma < \gamma_m$ 区间时, 由于涡旋运动产生了有限电阻, 但仍然有部分涡旋被钉扎, 运动状态表现为塑性流动状态, 流阻随驱动电流的增大表现为复杂的行为. 同时随着磁场越大, 涡旋塑性流动状态越复杂. 当驱动电流 $\gamma > \gamma_m$ 时, 涡旋全部被融化形成了关联格子的集体运动, 电压随电流的增大成线性增加关系, 流阻表现为一个稳定的常数值. 高温超导体 JV 格子动力学相变和相图还有待于进一步的研究.

随后, 我们固定驱动电流 $\gamma = 0.2$, 计算 JV 电压 V 随磁场 h 的变化曲线表示在图 3 中. 从图中的 $V-$

h 曲线形状可以发现当磁场小于 0.6 时涡旋被钉扎, 当磁场等于 0.6 时部分涡旋退钉扎开始运动引起耗散电阻. 我们定义引起涡旋开始运动的磁场为退钉扎临界磁场 $h_d (= 0.6)$. 同时我们还定义引起涡旋全部退钉扎的磁场为融化临界磁场 $h_m (= 5)$. 当磁场在 $h_d < h < h_m$ 范围内, 部分涡旋退钉扎, 运动成塑性流动状态. 当磁场增大到 $h > h_m$, 并在一个比较大的范围内, 融化后的涡旋运动形成关联格子的集体弹性运动. 我们发现 JV 格子的关联运动电压 V 和电阻 R_{JV} 随磁场增加保持稳定状态, 并随磁场的变化出现周期性振荡行为, 振荡周期 h_p 稳定在 $h_p = 1$ 的值. 我们将图 3 中磁场在 $5 < h < 14$ 范围内的 $V-h$ 曲线表示在插图中. 可以看出当磁场为 6 (a 点), 7 (c 点) 等值时, 系统处于高电阻态, 当磁场为 6.5 (b 点), 7.5 等值时, 系统处于低电阻态. 电阻变化振荡周期 $h_p = 1$.

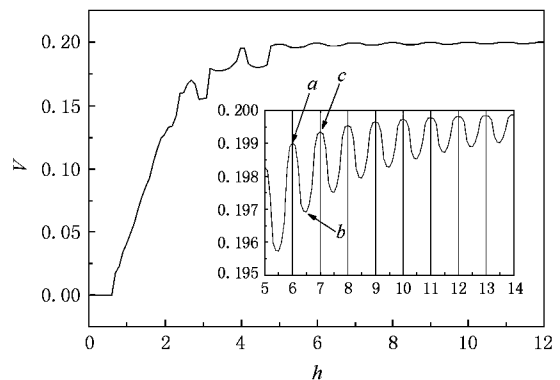


图3 驱动电流 $\gamma = 0.2$ 时 JV 电压 V 随磁场 h 的变化曲线

为了解释电压随磁场周期性振荡的原因, 我们将图 3 插图中磁场在 a, b, c 三点时的 JV 格子图像表示在图 4 (a) (b) 和 (c) 中. 图 4 (a) 和 (c) 对应于系统处于高电阻态的涡旋位型, (b) 对应于系统处在低电阻态的涡旋位型. 图中曲线为 $\sin \phi_i$ 表示约瑟夫森电流, JV 中心的位置由 $\sin \phi_i = 0$ 和 $\frac{\partial \sin \phi_i}{\partial x} < 0$ 决定.

首先, 我们分析图 4 中 JV 格子的直观图像. 图 4 (a) 中 $h = 6$ 表示在 $x = 0$ 和 L 边界条件的作用下, 使得每一层结中的涡旋相位变化在 $x = 0$ 到 L 之间包含 6 个完整的周期 ($\Delta \phi_i \equiv \phi_{i, x=L} - \phi_{i, x=0} = h2\pi$), 即每一层结中包含 6 个涡旋中心. 从图中还可以看到在同一 x 位置上下两层结的涡旋相位差等于 π , JV 中心形成了周期性的三角形点阵格子. 而在图 4 (b) 中磁场增加到 $h = 6.5$ 时, 第一层结中包含 6 个

涡旋中心,第二层结中包含 7 个涡旋中心,即在每两个结中增加一个涡旋中心.这种结构的变化使得在同一 x 位置上下两层结的相位差是无序的.这也就是说每当磁场增加 0.5,使得三角形的 JV 点阵改变成为无序格子态.图 4(c)中 $h = 7$,磁场从 6 增加到 7 使得每一层结中含 JV 中心个数从 6 增加到 7,但仍然保持三角形的 JV 周期性结构.

场增加呈周期性振荡的原因.平行于 Cu-O 层的磁场从边界流入样品,磁通只能以量子化的整数进入结中.由于边界对量子化磁通的调制,进入的涡旋形成不同构型的约瑟夫森涡旋格子.在图 4(a)与(c)中,三角形周期性格子的整体运动时位相运动始终有序,所有 $V(x, \tau)$ 相叠加,形成 JV 流阻是一个稳定的高阻值.图 4(b)中,如果样品中每一层增加分数个涡旋量子,使得原周期性格子被破坏.这种结构的变化使得在同一 x 位置上下两层结的相位差是无序的.不同位置上的电压 $V(x, \tau)$ 有相消部分. JV 流阻是一个稳定的低阻值.在三角形格子情况下,平均每个结中增加整数个涡旋中心时为高阻态,平均每个结中增加半整数个涡旋中心时为低阻态.振荡周期 $h_p = 1$ 对应于每层约瑟夫森结中增加一个涡旋.因此 JV 格子流阻随磁场变化的振荡行为是由于边界对量子化磁通的调制,不同构型的 JV 格子流动, $V(x, \tau)$ 的相互叠加和相消形成流阻的振荡行为.

4. 结 论

本文采用 sine-Gordon 方程组来研究高温超导体中的 JV 格子动力学,计算了 JV 运动电压随磁场和驱动电流的变化规律.得到当磁场密度增大到一个临界值后, JV 电压和流阻随着磁场的变化出现周期性振荡行为.我们研究了产生周期振荡时的 JV 格子位型,发现产生周期振荡的原因是由于边界条件的限制.约瑟夫森涡旋格子表现出不同的构型.高温超导层状结构导致了 z 方向很强的本征钉扎使涡旋流动表现出相干性.

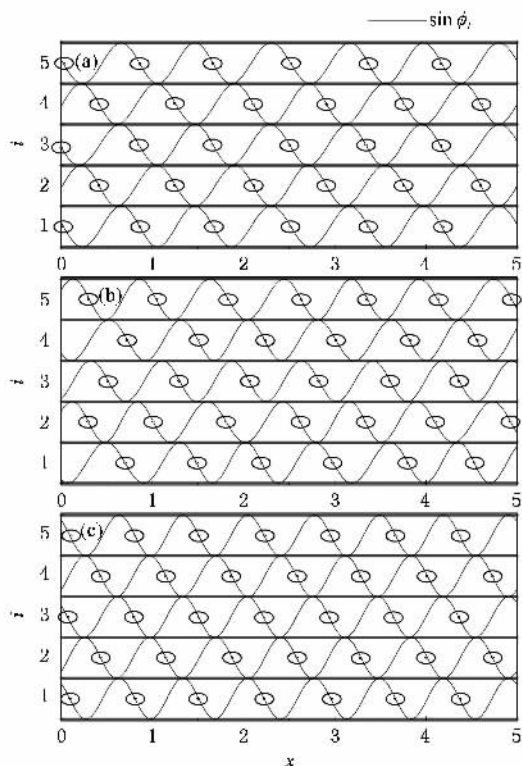


图 4 JV 格子图形(椭圆表示 JV 中心,曲线 $\sin \phi_i$ 表示约瑟夫森电流值, i 表示约瑟夫森结层, x 表示位置)

最后,我们从图 4 中 JV 格子图像解释流阻随磁

[1] He G L, He Y W, Zhao Z G, Liu M 2006 *Acta Phys. Sin.* **55** 839 (in Chinese) [何国良、贺延文、赵志刚、刘 楣 2006 物理学报 **55** 839]

[2] Bending Simon J, Dodgson Matthew J W 2005 *J. Phys. : Condens. Matter* **17** 955

[3] Kleiner R, Steinmeyer F, Kunkel G *et al* 1992 *Phys. Rev. Lett.* **68** 2394

[4] Koshelev A E 2003 *Phys. Rev. B* **68** 094520

[5] Zhu B Y, Wang H B, Kim S M *et al* 2005 *Phys. Rev. B* **72** 174514

[6] Kadowaki K, Kakeya I, Yamamoto T *et al* 2006 *Physica C* **437-438** 111

[7] Nagao M, Urayama S, Kim S M *et al* 2006 *Phys. Rev. B* **74** 054502

[8] Ooi S, Mochiku T, Hirata K 2002 *Phys. Rev. Lett.* **89** 247002

[9] Machida M 2003 *Phys. Rev. Lett.* **90** 037701

[10] Hirata K, Ooi S, Sadki E H *et al* 2003 *Physica B* **329-333** 1332

[11] Yu S, Ooi S, Mochiku T *et al* 2005 *Physica C* **426-431** 56

[12] Bae Myung-Ho, Lee Hu-Jong, Choi Jae-Hyun 2007 *Phys. Rev. Lett.* **98** 027002

[13] Saki S, Bodin P 1993 *J. Appl. Phys.* **73** 2411

Oscillations of Josephson-vortex flow resistance in high- T_c superconductors^{*}

You Yu-Xin[†] Zhao Zhi-Gang Wang Jin Liu Mei

(*Department of Physics , Southeast University , Nanjing 210096 , China*)

(Received 7 January 2008 ; revised manuscript received 20 April 2008)

Abstract

Using the coupled sine-Gordon equations ,we investigate the motion of Josephson vortex in high- T_c superconductors . It is found that the oscillation behavior in the average voltage and resistance of Josephson vortex flow appear with the increasing of magnetic field in a fixed bias current . The period of the oscillation corresponds to the field , which has the magnitude of adding one Josephson vortex quantum per one intrinsic Josephson junction .

Keywords : Josephson-vortex , vortex lattice , High- T_c superconductors

PACC : 7460E , 7470J , 7450

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10574021 , 10647114) and the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China (Grant No. 20060286044).

[†] Corresponding author. E-mail : tiki82@e172.com